



第三单元 层次存储器系统

第一讲 层次存储器系统 动态存储器

刘卫东

计算机科学与技术系

本单元内容提要



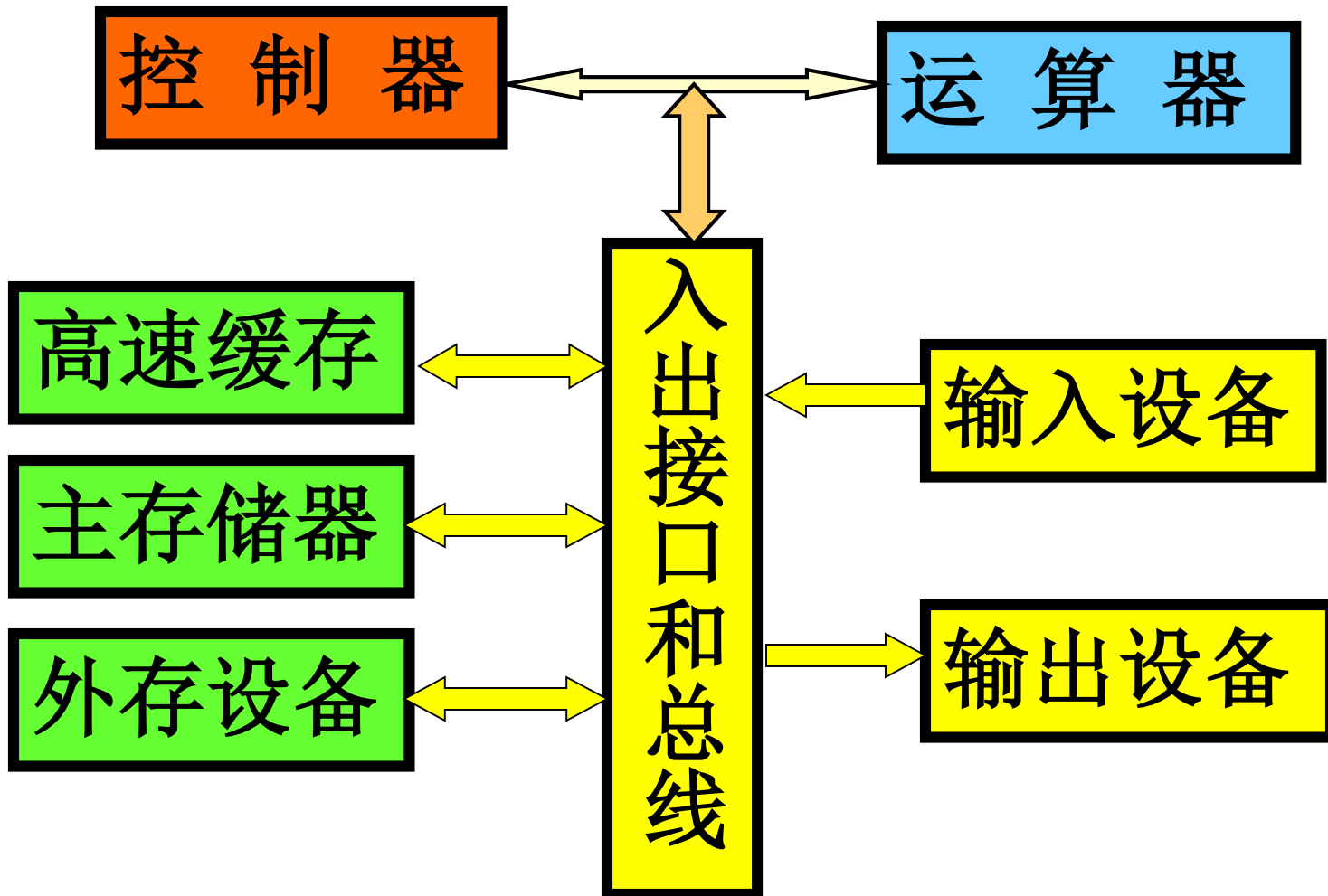
- ❖ 第一讲 层次存储器系统概述及动态存储器
- ❖ 第二讲 静态存储器及高速缓冲存储器
- ❖ 第三讲 高速缓冲存储器的组成与运行原理
- ❖ 第四讲 虚拟存储器的运行原理
- ❖ 第五讲 磁表面存储设备的存储原理与组成
- ❖ 第六讲 MIPS系统异常处理和响应

本讲概要



- ❖ 存储器系统功能
- ❖ 存储器系统的设计目标
- ❖ 需要解决的问题
- ❖ 层次存储器系统
- ❖ 动态存储器的组成与原理

计算机硬件系统



存储器地位和作用



- ❖ 存储程序使计算机走向通用。
- ❖ 计算机中用来存放程序和数据的部分，是Von Neumann结构计算机的重要组成部分，是计算机的**中心**。
- ❖ 程序和数据的特点
 - ❑ 源程序、汇编程序、机器语言程序
 - ❑ 各种类型的数据
 - ❑ 共同点：二进制数据

对存储介质的基本要求



- ✿ 能够有两个稳定状态来表示二进制中的“0”和“1”
- ✿ 容易识别
- ✿ 两个状态能方便地进行转换
- ✿ 几种常用的存储方式
 - ▣ 磁颗粒、 半导体(电平/电容)、 光

早期存储器



❖ 水银延迟线存储器

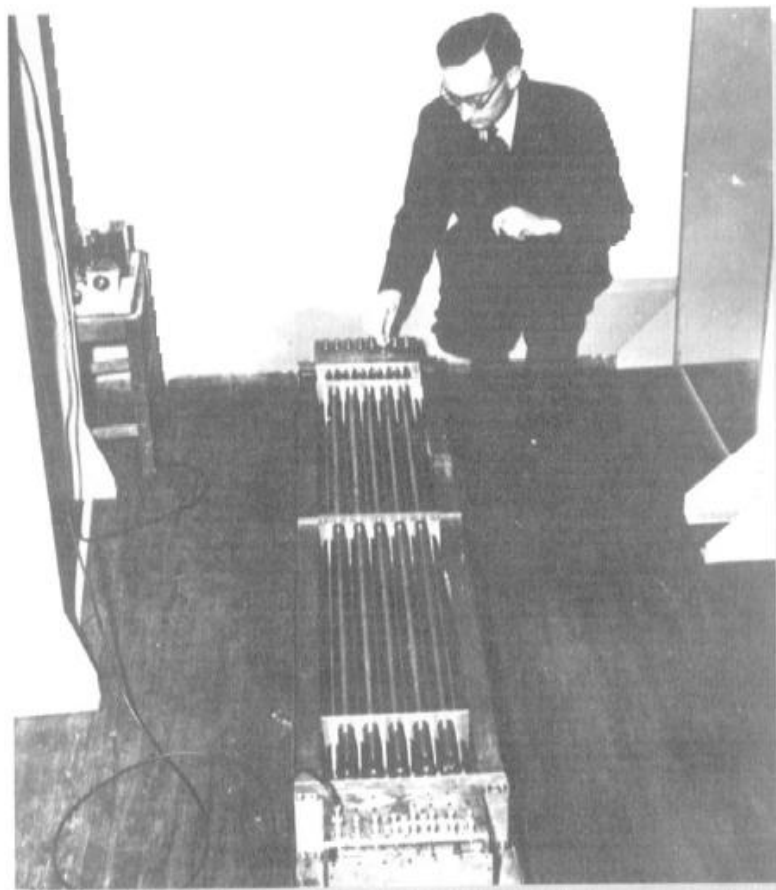
- ❖ EDSAC, 1949

- ❖ Maurice Wilkes

- ❖ 1967年 Turing 奖

- ❖ 存储原理

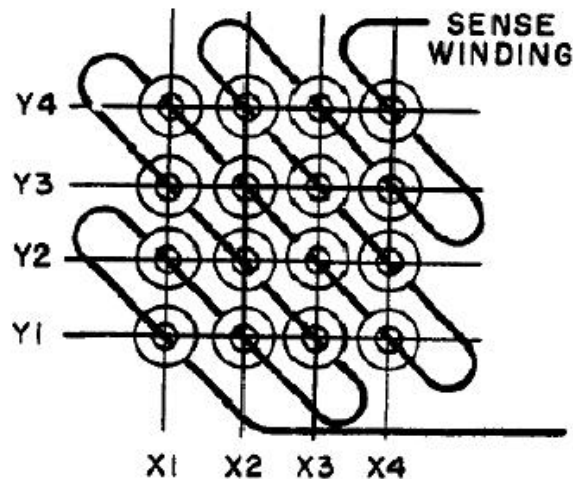
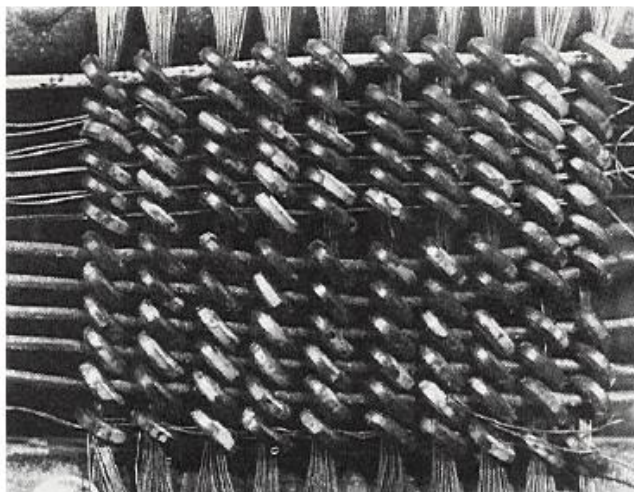
 - ◆ 水波



磁芯存储器



- 圆柱型陶瓷上涂磁粉
- 手工穿线，水手结
- 消磁后重写



半导体存储器



❖ 存储原理

- ❖ MOS管寄生电容

- ❖ 触发器

❖ 访问机制

- ❖ 随机访问

❖ 分类

- ❖ ROM、RAM

- ❖ SRAM、DRAM



按访问方式分类

❖ 随机访问存储器 (RAM)

- ❖ 访问时间与存放位置无关
- ❖ 半导体存储器

❖ 顺序访问存储器 (SAM)

- ❖ 按照存储位置依次访问
- ❖ 磁带存储器

❖ 直接访问存储器 (DAM)

- ❖ 随机+顺序
- ❖ 磁盘存储器

❖ 关联访问存储器 (CAM)

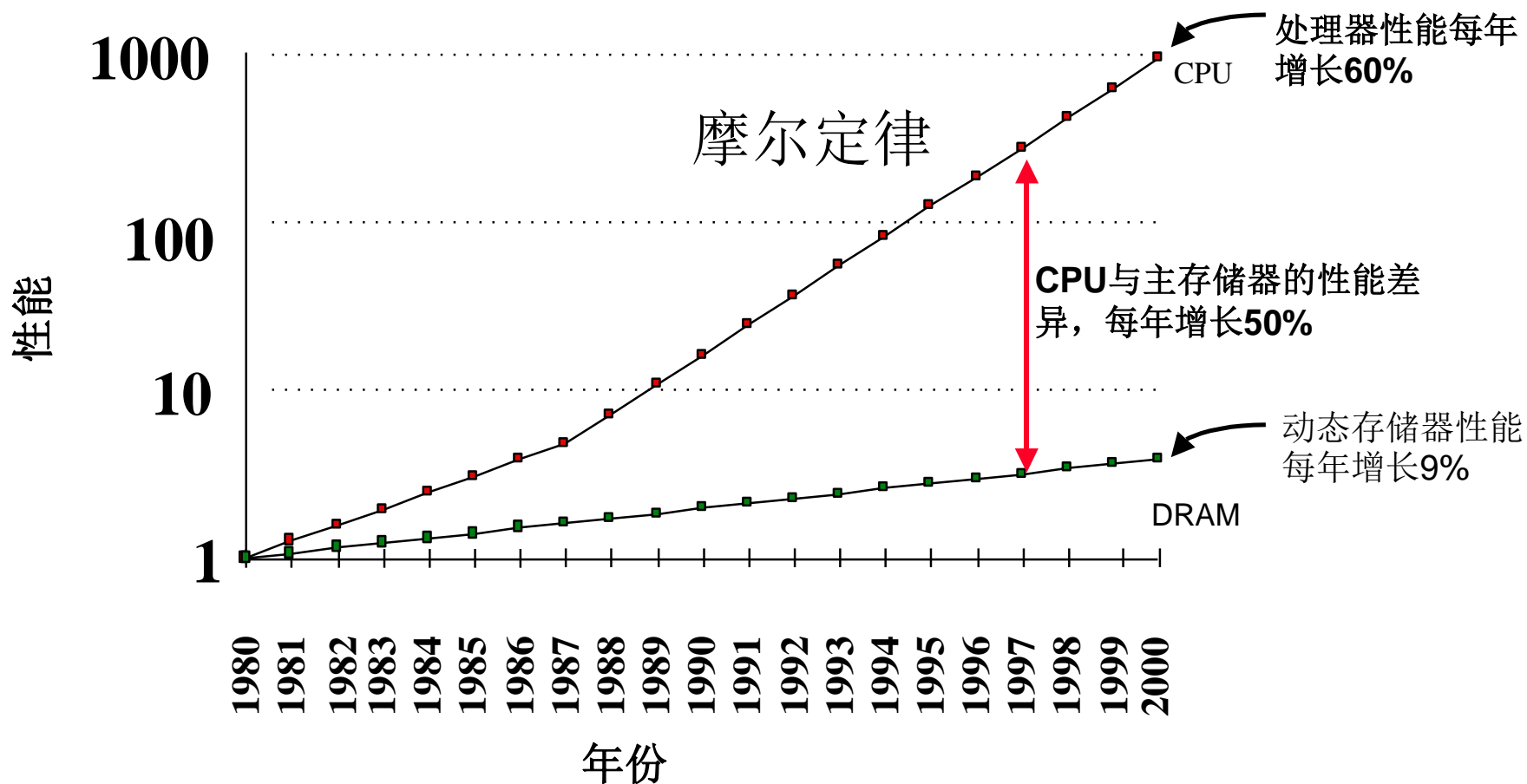
- ❖ 根据内容访问
- ❖ Cache和TLB

存储器系统设计目标



- ✚ 尽可能快的存取速度
 - ✚ 应能基本满足CPU对数据的访问要求
- ✚ 尽可能大的存储空间
 - ✚ 可以满足程序对存储空间的要求
- ✚ 尽可能低的单位成本（价格/位）
 - ✚ 用户能够承受的范围内
- ✚ 较高的可靠性

Moore定律



微电子技术发展趋势



容量

速度

逻辑电路: 2倍/ 3 年

2倍/ 3 年

DRAM: 4倍/ 3 年

2倍/ 10 年

磁盘: 4倍/ 3 年

2倍/ 10 年

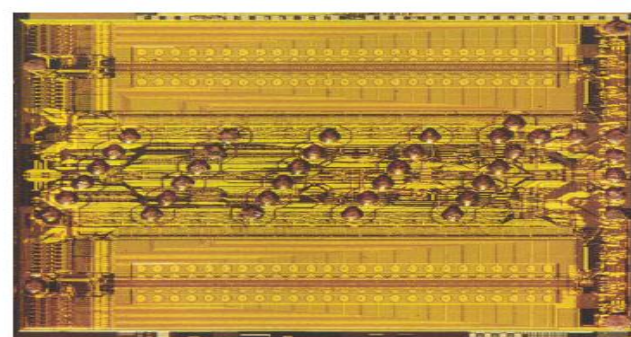
DRAM		
Year	Size	Cycle Time
1980	64 Kb	250 ns
1983	256 Kb	220 ns
1986	1 Mb	190 ns
1989	4 Mb	165 ns
1992	16 Mb	145 ns
1995	64 Mb	120 ns

1000:1! 2:1!

DRAM的发展



年代	容量	价格 (\$/MB)	总访问时间 (新行/列)	列访问时间 (现访问行)
1980	64 Kbit	1500	250 ns	150 ns
1983	256 Kbit	500	185 ns	100 ns
1985	1 Mbit	200	135 ns	40 ns
1989	4 Mbit	50	110 ns	40 ns
1992	16 Mbit	15	90 ns	30 ns
1996	64 Mbit	10	60 ns	20 ns
1998	128 Mbit	4	60 ns	10 ns
2000	256 Mbit	1	55 ns	7 ns
2004	512 Mbit	0.25	50 ns	5 ns
2007	1 Gbit	0.05	40 ns	1.25 ns



存储器对性能的影响



- 假定某台计算机的处理器工作在：
 - 主频 = 1GHz (机器周期为1 ns)
 - CPI = 1.1
 - 50% 算逻指令, 30% 存取指令, 20% 转移指令
- 再假定其中10% 的存取指令会发生数据缺失, 需要50个周期的延迟。
- $$\begin{aligned}\text{CPI} &= \text{理想 CPI} + \text{每条指令的平均延迟} \\ &= 1.1 + (0.30 \times 0.10 \times 50) \\ &= 1.1 \text{ cycle} + 1.5 \text{ cycle} = 2.6 \text{ CPI!}\end{aligned}$$
- 也就是说, 处理器58 %的时间花在等待存储器给出数据上面!
- 每 1% 的指令的数据缺失将给CPI附加 0.5个周期!

存储器设计目标



❖ 目标

- ❑ 大容量、高速度、低成本、高可靠性

❖ 目前现实

- ❑ 大容量存储器速度慢
- ❑ 快速存储器容量小

❖ 如何实现我们的目标呢？

- ❑ 层次存储器系统
- ❑ 采用并行技术

层次存储器系统



✚ 高速度

- ▣ 静态存储器速度高
- ▣ 设置较小容量的高速缓冲存储器

✚ 大容量

- ▣ 动态存储器价格适中，速度适中
- ▣ 可作为主存储器

✚ 低成本

- ▣ 磁盘存储器价格低廉
- ▣ 作为辅助存储器，暂存CPU访问频率不高的数据和程序
- ▣ 作为虚拟存储器的载体



程序运行的局部性原理

程序运行时的局部性原理表现在：

在一小段时间内，最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问

在空间上 这些被访问的程序和数据往往集中在一小片存储区

在访问顺序上，指令顺序执行比转移执行的可能性大(大约 5:1)

合理地把程序和数据分配在不同存储介质中

层次之间应满足的原则



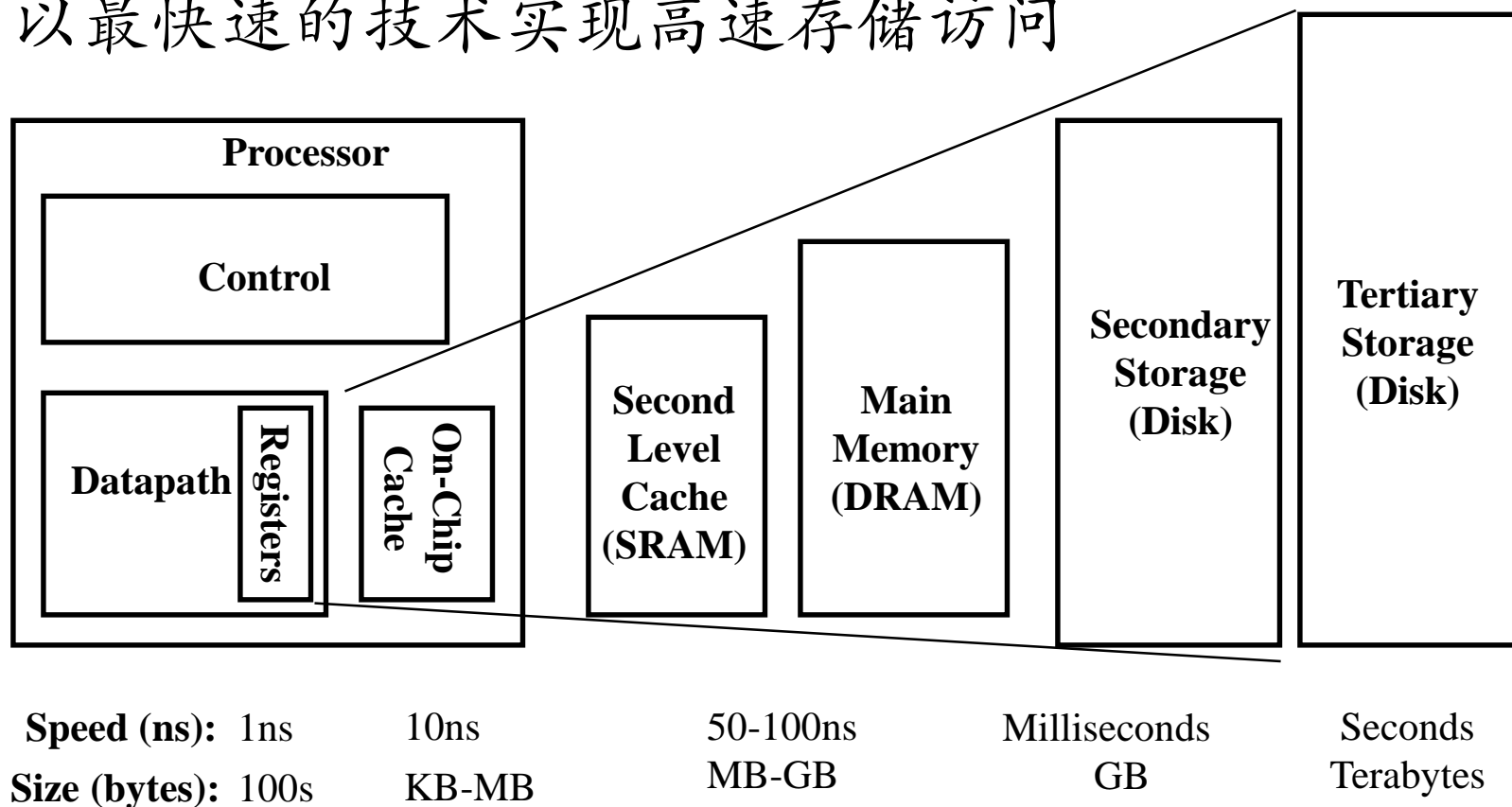
- (1). **一致性原则**：处在不同层次存储器中的同一个信息应保持相同的值。
- (2). **包含性原则**：处在内层的信息一定被包含在其外层的存储器中，反之则不成立，即内层存储器中的全部信息，是其相邻外层存储器中一部分信息的复制品。

层次存储器系统



利用程序的局部性原理:

- 以最低廉的价格提供尽可能大的存储空间
- 以最快速的技术实现高速存储访问



现代计算机存储器系统



寄存器 Register

高速缓存 Cache

主存储器 Main Memory

主存储器

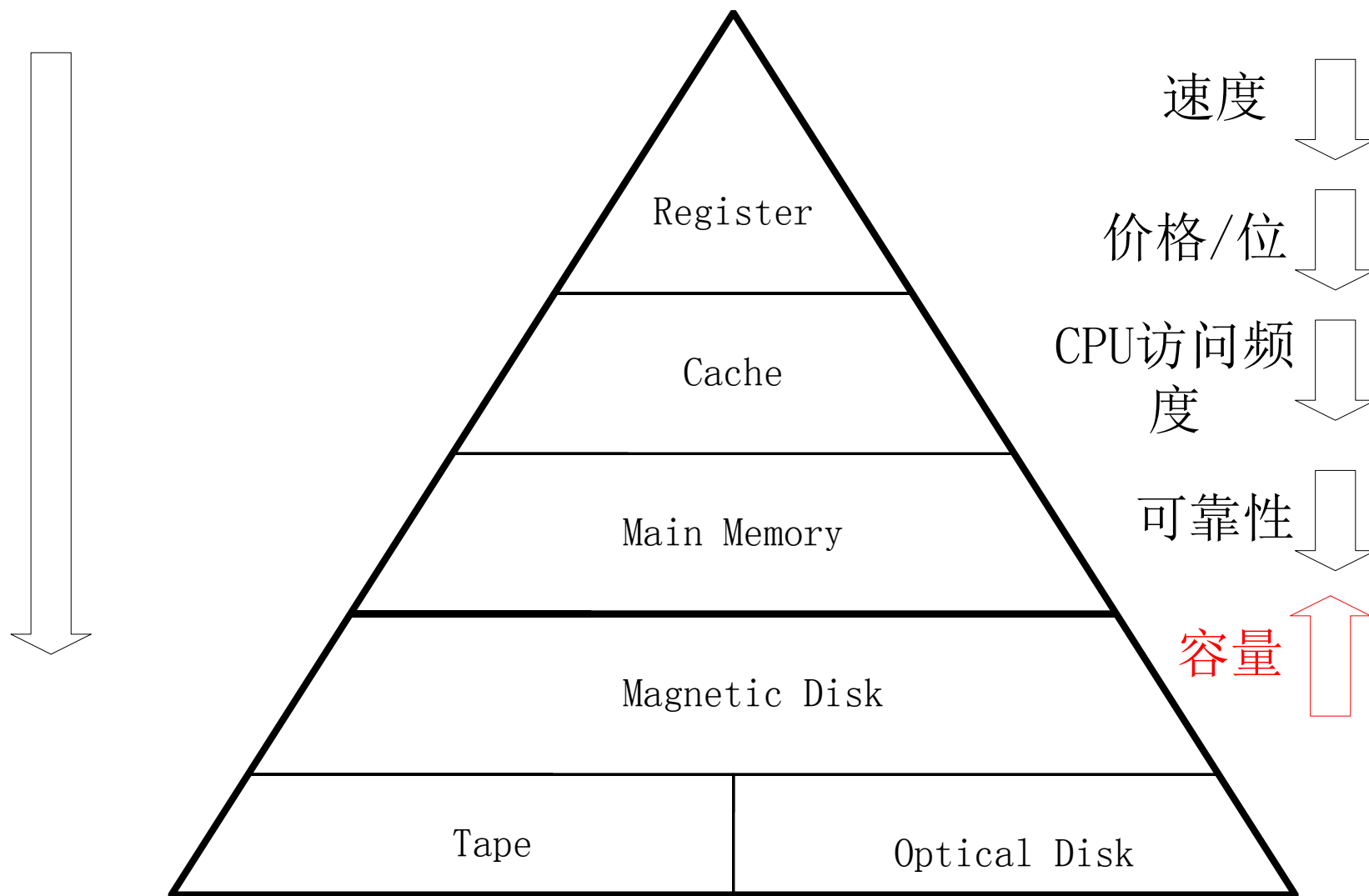
磁盘 Disk

磁带 Tape

光盘 Compact Disc

辅助存储器

不同类型存储器比较



并行技术



✚ 主存的一体多字

- ✚ 一个读写体，每次多个字

✚ 单字多体

- ✚ 多个读写体，交叉编址

✚ 多端口存储器



主存储器的作用和连接

存储正处在运行中的程序和数据(或一部分)的部件， 通过地址 数据 控制 三类总线与 CPU、与其它部件连通



地址总线



地址总线用于选择主存储器的一个存储单元（字或字节），其位数决定了能够访问的存储单元的最大数目，称为最大可寻址空间。例如，当按字节寻址时，20位的地址可以访问1MB的存储空间，32位的地址可以访问4GB的存储空间。

数据总线



数据总线用于在计算机各功能部件之间传送数据，数据总线的位数（总线的宽度）与总线时钟频率的乘积，与该总线所支持的最高数据吞吐（输入/输出）能力成正比。

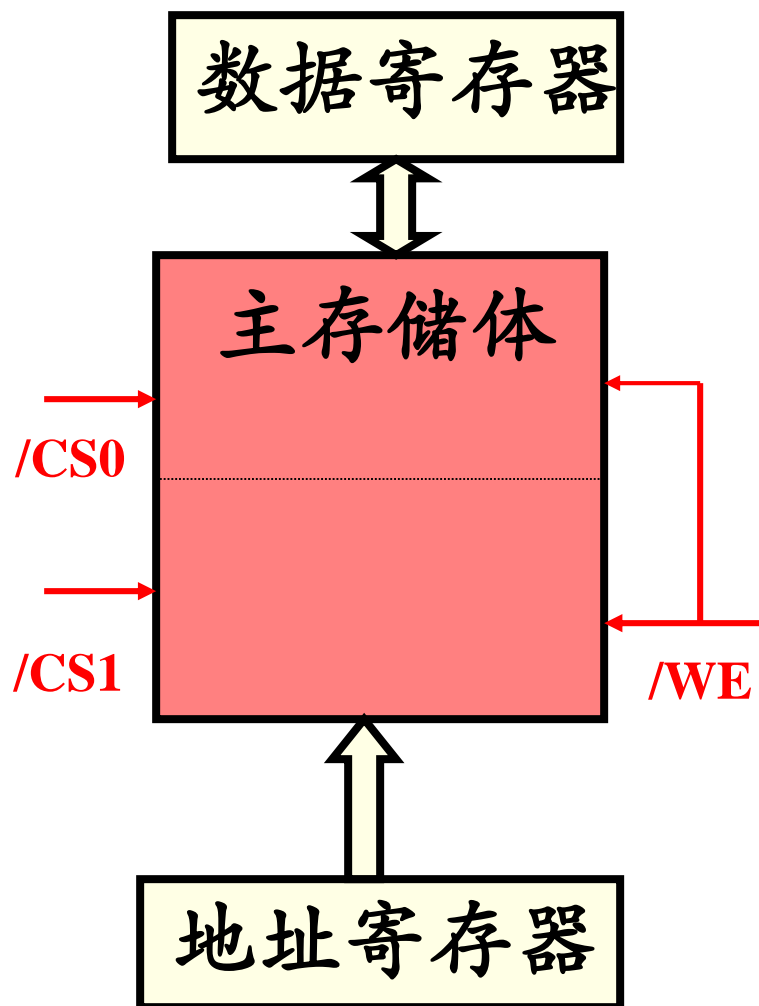
控制总线



控制总线用于指明总线的工作周期类型和本次入/出完成的时刻。总线的工作周期可以包括主存储器读周期、主存储器写周期、I/O设备读周期、I/O设备写周期，即用不同的总线周期来区分要用哪个部件（主存或I/O 设备）和操作的性质（读或写）；还有直接存储器访问（DMA）总线周期等。



主存储器的读写过程



读过程:

给出地址

给出片选与读命令

保存读出内容

写过程:

给出地址

给出片选与数据

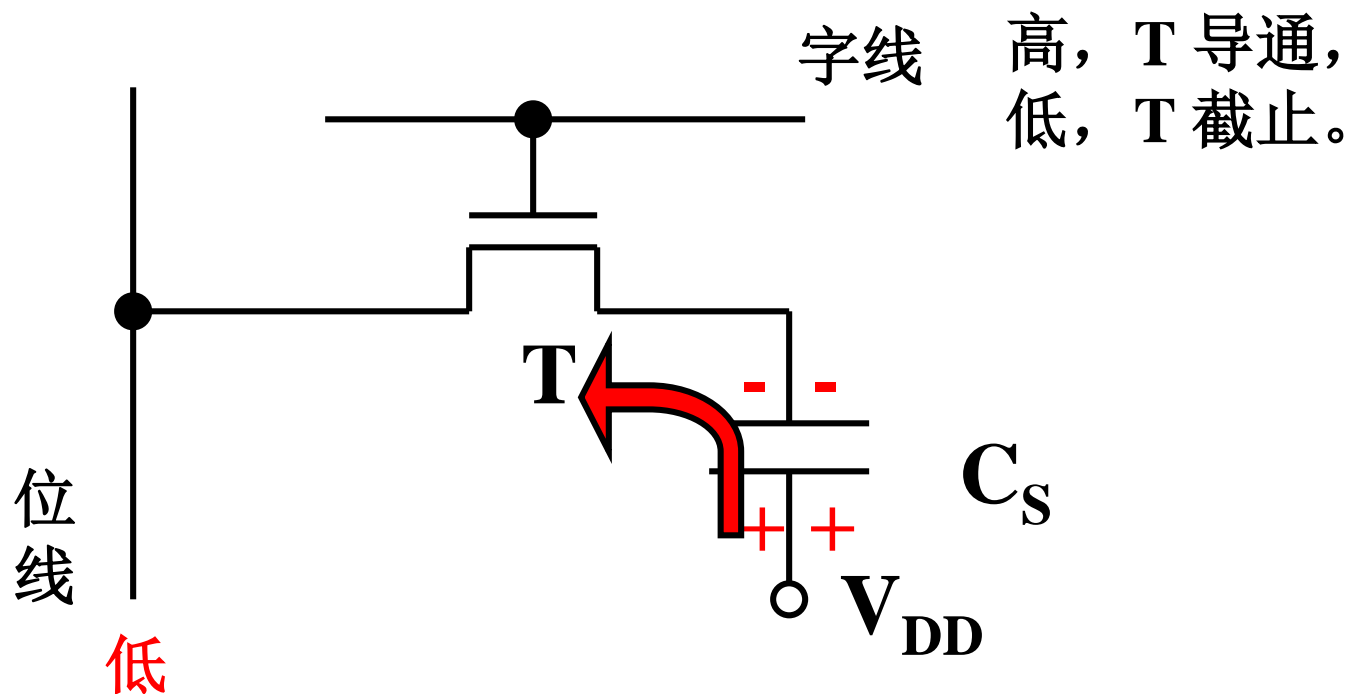
给出写命令

动态存储器的存储原理



❖ 动态存储器，是用金属氧化物半导体（MOS）的单个MOS管来存储一个二进制位（bit）信息的。信息被存储在MOS管T的源极的寄生电容 C_S 中，例如，用 C_S 中存储有电荷表示1，无电荷表示0。

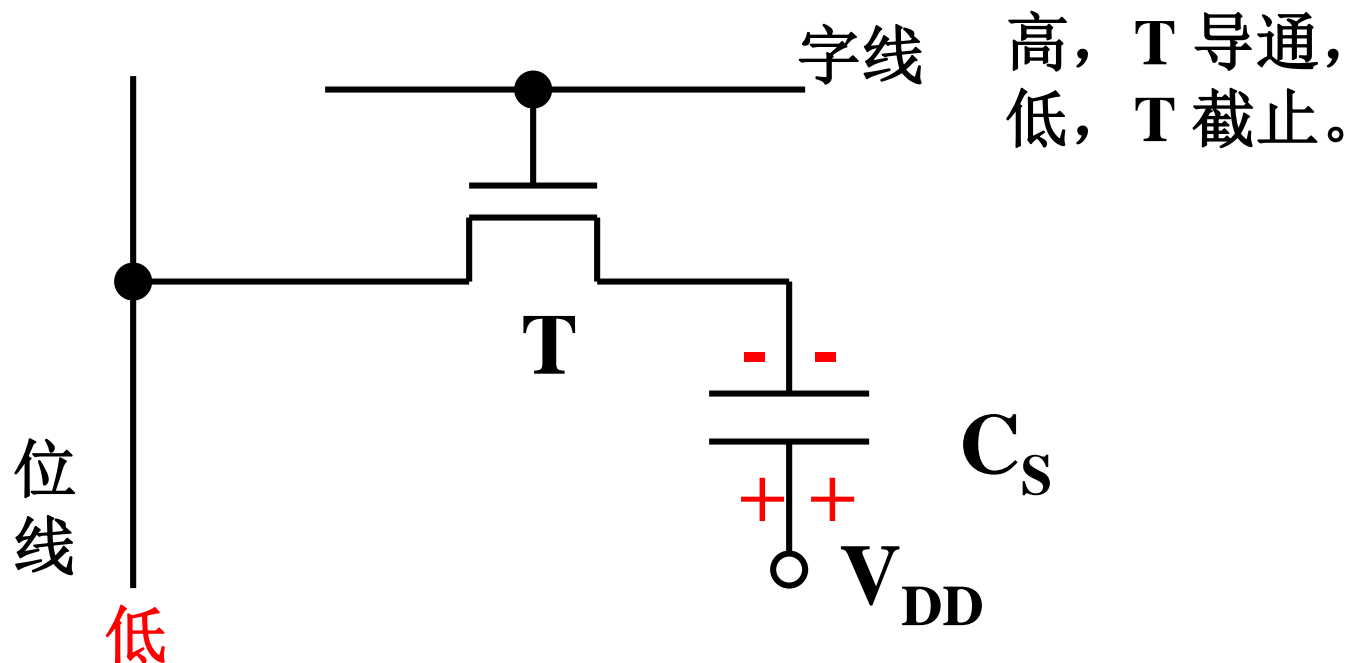
动态存储器的写过程



写 1：使位线为低电平，若 C_S 上无电荷，则 V_{DD} 向 C_S 充电；把 1 信号写入了电容 C_S 中。

若 C_S 上有电荷，则 C_S 的电荷不变，保持原记忆的 1 信号不变。

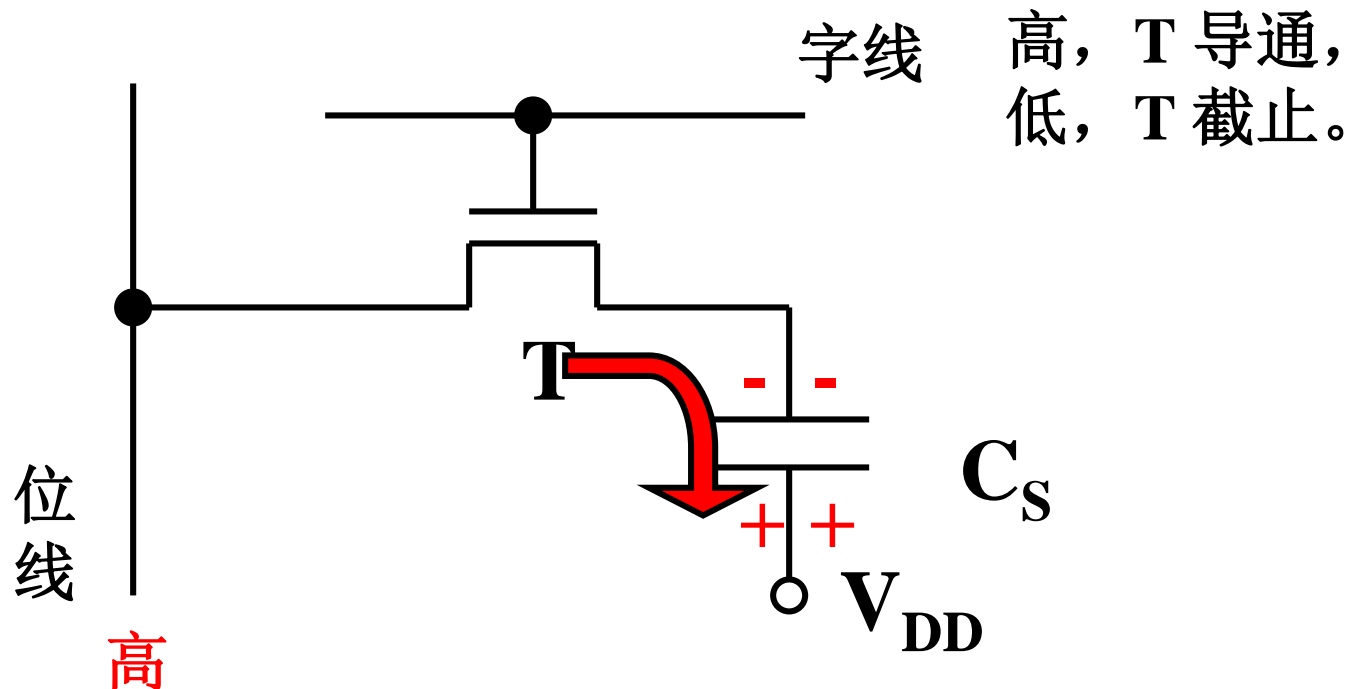
动态存储器的写过程



写 1：使位线为低电平，若 C_S 上无电荷，则 V_{DD} 向 C_S 充电；
把 1 信号写入了电容 C_S 中。

若 C_S 上有电荷，则 C_S 的电荷不变，
保持原有的内容 1 不变；

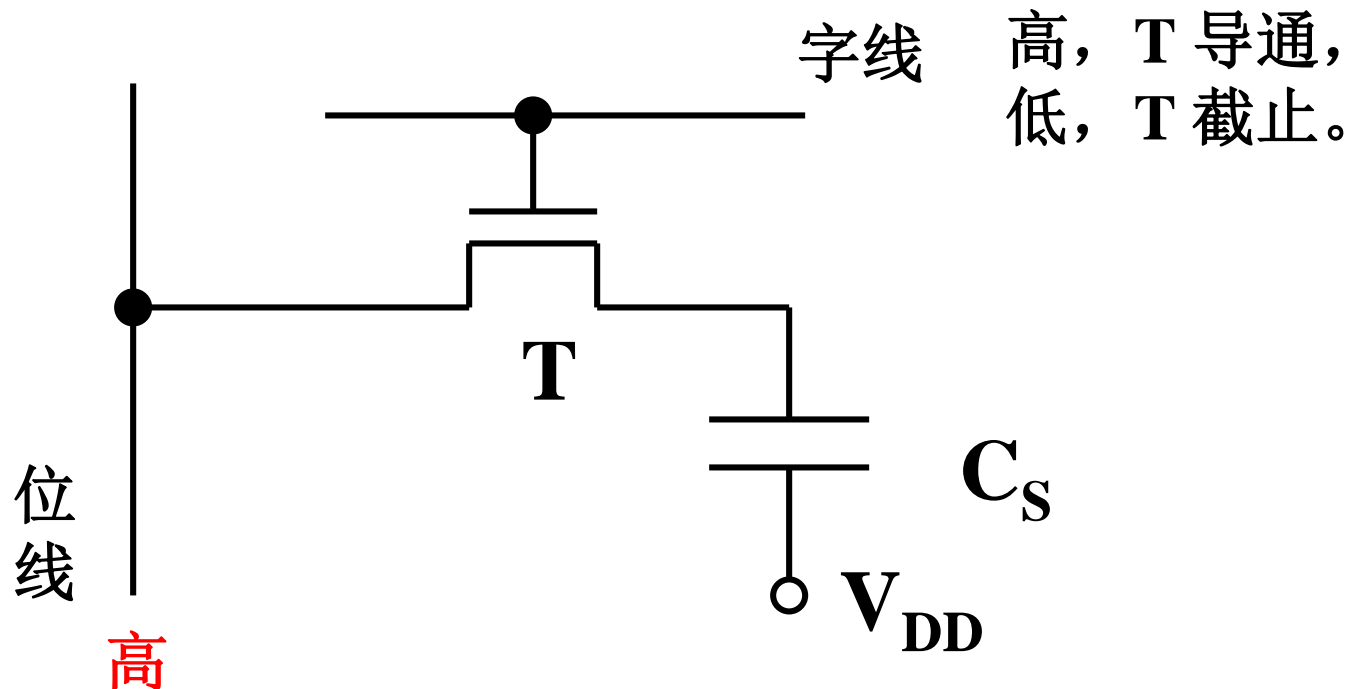
动态存储器的写过程



写 0：使位线为高电平，若 C_S 上有电荷，则 C_S 通过 T 放电；
把 0 信号写入了电容 C_S 中。

若 C_S 上无电荷，则 C_S 无充放电动作，
保持原记忆的 0 信号不变。

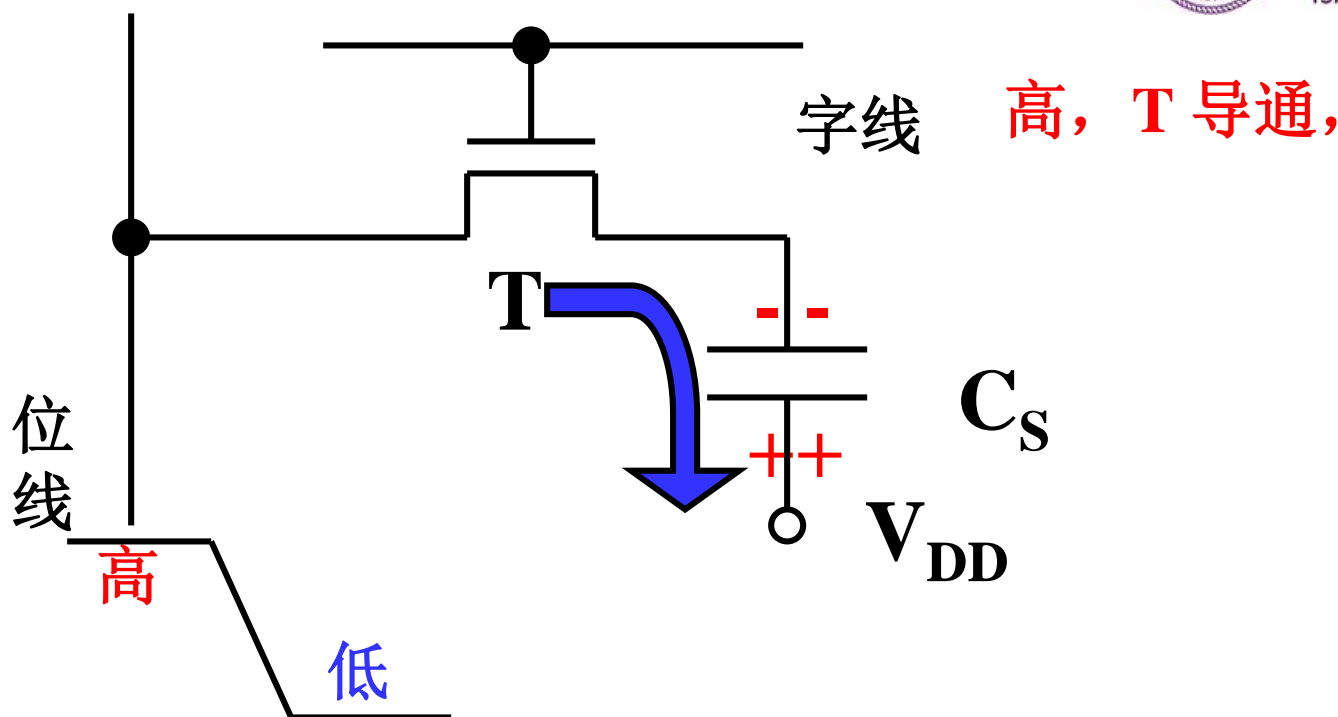
动态存储器的写过程



写 0：使位线为高电平，若 C_S 上有电荷，则 C_S 通过 T 放电；
把 0 信号写入了电容 C_S 中。

若 C_S 上无电荷，则 C_S 无充放电动作，
保持原记忆的 0 信号不变。

动态存储器的读过程



读操作： 首先使位线充电至高电平，当字线来高电平后，T导通，

- ①. 若 C_s 上无电荷，则位线上无电位变化，读出为 0；
- ②. 若 C_s 上有电荷，则会放电，并使位线电位由高变低，

接在位线上的读出放大器会感知这种变化，读出为 1。

动态存储器工作特点



破坏性读出

- 读出时被强制清零

- 预充电延迟

需定期刷新

- 集中刷新

 - 停止读写，逐行刷新

- 分散刷新

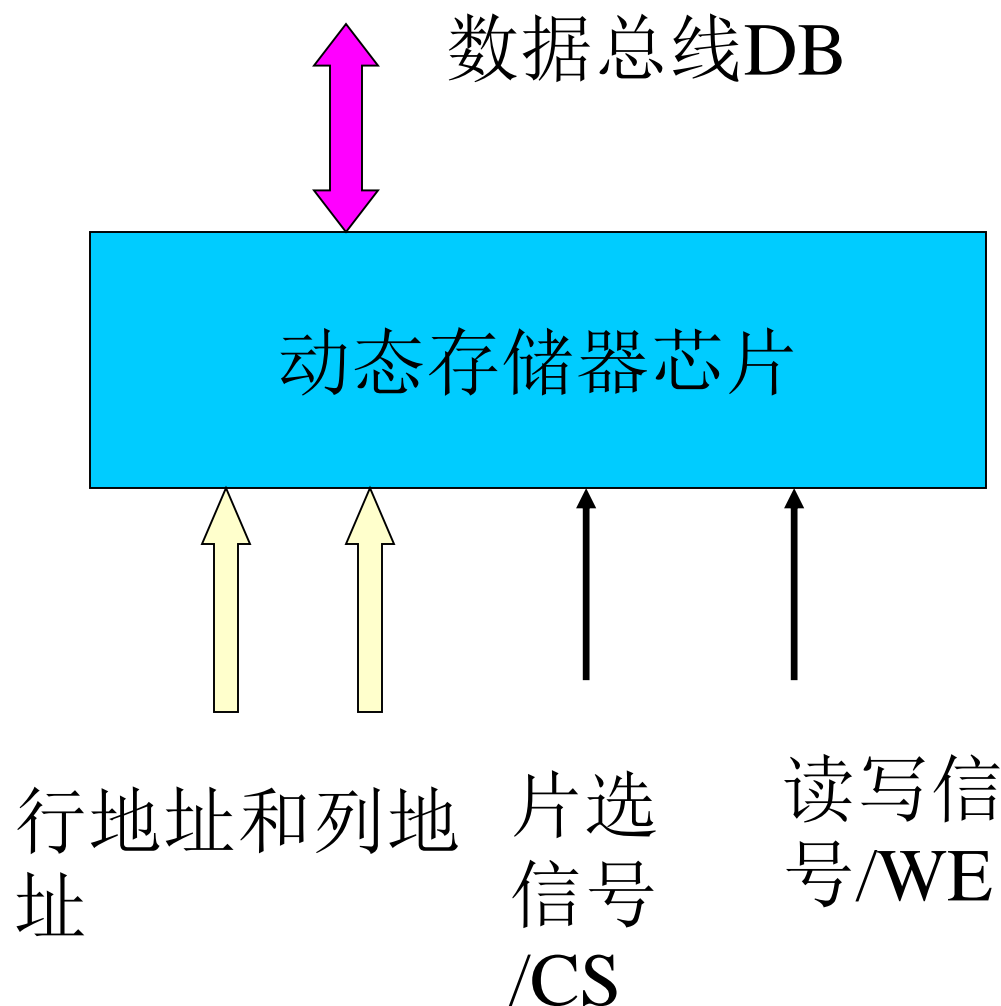
 - 定时周期性刷新

快速分页组织



动态存储器读写过程

动态存储器集成度高，存储容量大，为节约管脚数，地址分为行地址和列地址

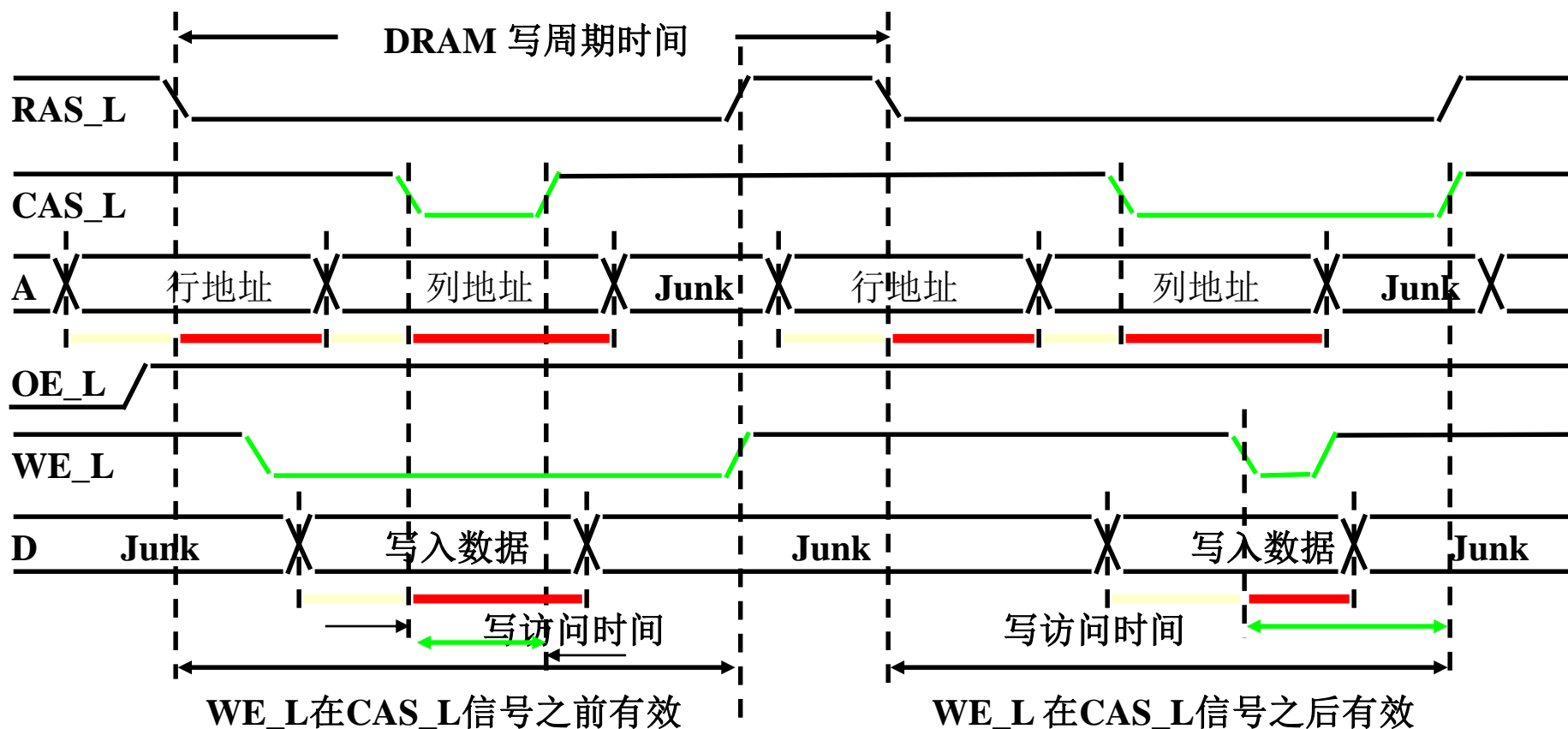
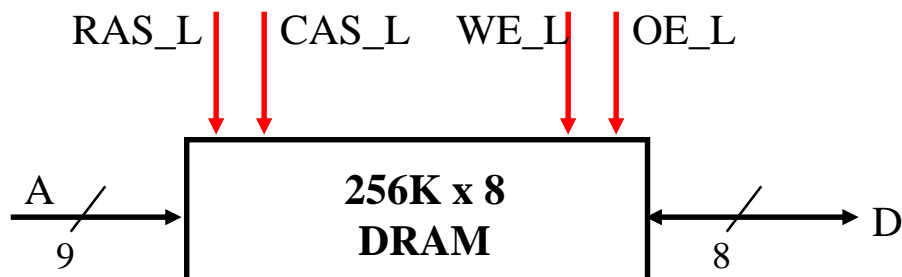


DRAM 写时序



DRAM 写访问开始于:

- RAS_L信号有效
- 两种写方式: WE_L信号早和晚于CAS_L信号有效

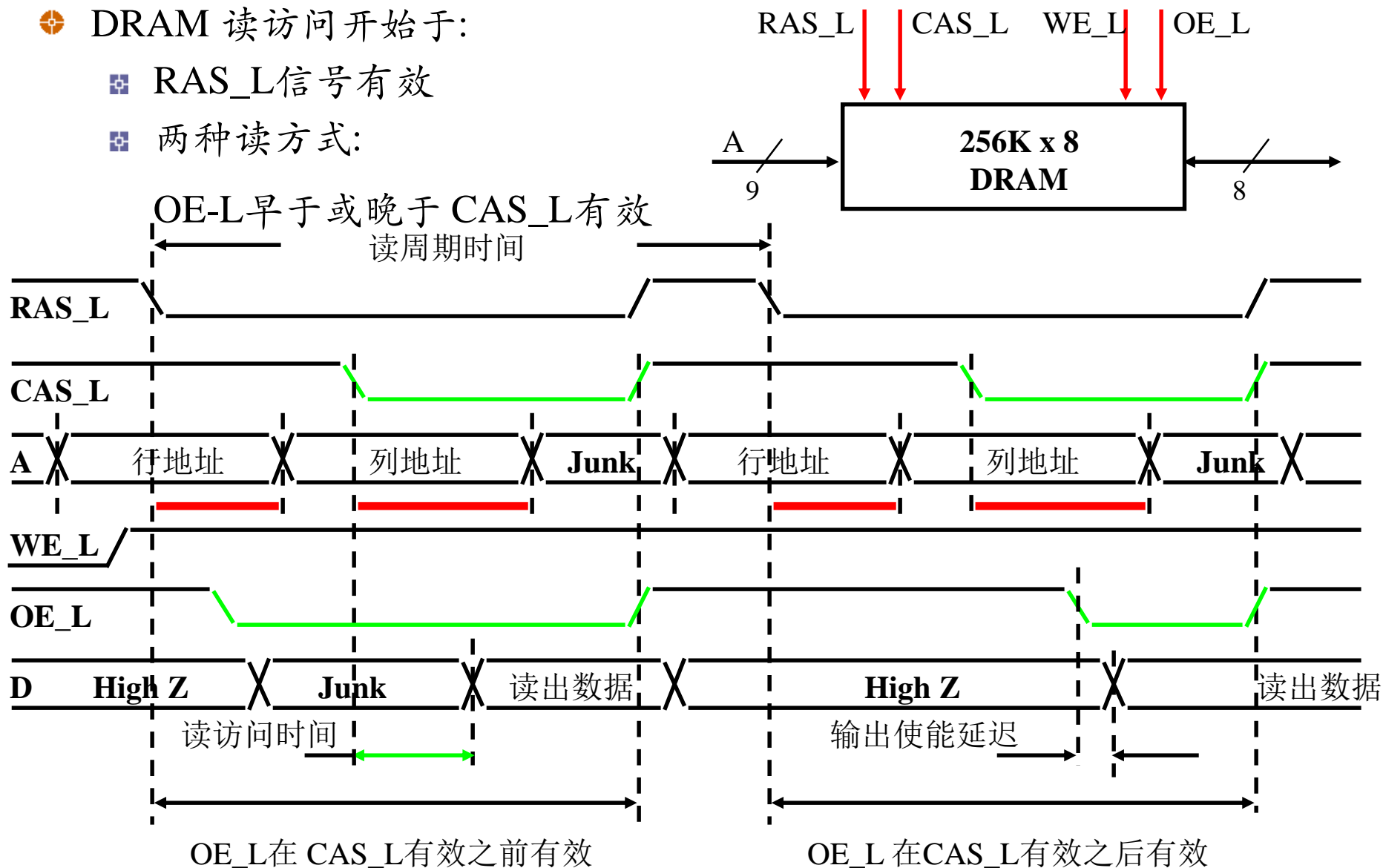


DRAM 读时序



DRAM 读访问开始于:

- RAS_L信号有效
- 两种读方式:



程序的局部性原理:

- 时间局部性: 最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问
- 空间局部性: CPU很可能访问最近被访问过的地址单元附近的地址单元。

利用程序的局部性原理:

- 使用尽可能大容量的廉价、低速存储器存放程序和数据。
- 使用高速存储器来满足CPU对速度的要求。

动态存储器DRAM

- 电容充放电来存储数据
- 集成度高、容量大、能耗低、速度慢

阅读和思考



❖ 阅读

❖ 教材5.1节

❖ 思考

❖ 程序的局部性原理指什么?为什么层次存储器系统能同时达到高性能/低成本/大容量的指标?

❖ 实践

❖ 继续完成大实验。